

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 23 年 5 月 26 日 (2011.5.26)

【公表番号】特表 2010-532585 (P2010-532585A)
 【公表日】平成 22 年 10 月 7 日 (2010.10.7)
 【年通号数】公開・登録公報 2010-040
 【出願番号】特願 2010-515106 (P2010-515106)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/322 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/322 J

【手続補正書】
 【提出日】平成 23 年 4 月 8 日 (2011.4.8)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 3 2
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 3 2 】

III. エピタキシャル層

再び図 1 を参照すると、エピタキシャル層 11 は、本技術分野で一般的に知られている手法によって、アニールされたシリコンウェーハの表面に堆積あるいは成長される。シリコンウェーハの表面には転位ループがないのが好ましい。ある実施態様では、エピタキシャル層の平均厚さは少なくとも約 $5\ \mu\text{m}$ である。ある実施態様では、注入基板をアニールして転位ループを生み出した後に、エピタキシャル層 11 を成長させる。別の実施態様では、注入基板をアニールして転位ループを生み出すとともに、エピタキシャル層 11 を成長させる。さらに別の実施態様では、エピタキシャル層を成長させる前あるいは成長させた後に、注入ウェーハを部分的にアニールして転位ループを生み出す。したがって、有利には、アニーリング工程およびエピタキシャル成長工程は同じ装置中で行なわれるだろう。